

**PATENT APPLICATION**

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re the Application of  
Kiyoshige SHIBAZAKI  
New U.S. Patent Application

jc598 U.S. PTO  
09/500988  
02/15/00  


Filed: February 15, 2000 Docket No.: 105401  
For: IMAGE-CAPTURING DEVICE AND ELECTRONIC CAMERA

**CLAIM FOR PRIORITY**

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

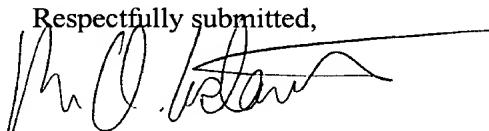
Japanese Patent Application No. 11-267166, filed September 21, 1999

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application:

X is filed herewith.

\_\_\_\_\_ was filed on \_\_\_\_\_ in Parent Application No. \_\_\_\_\_ filed \_\_\_\_\_.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,  


James A. Oliff  
Registration No. 27,075

Mario A. Costantino  
Registration No. 33,565

JAO:MAC/epb

**OLIFF & BERRIDGE, PLC**  
**P.O. Box 19928**  
**Alexandria, Virginia 22320**  
**Telephone: (703) 836-6400**

**DEPOSIT ACCOUNT USE  
AUTHORIZATION**  
Please grant any extension  
necessary for entry;  
Charge any fee due to our  
Deposit Account No. 15-0461

日本国特許庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

2000 U.S. PTO  
09/500988  
02/15/00  


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
in this Office.

出願年月日  
Date of Application:

1999年 9月21日

願番号  
Application Number:

平成11年特許願第267166号

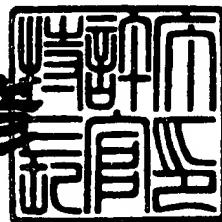
願人  
Applicant(s):

株式会社ニコン

2000年 1月28日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

近藤 隆彦



【書類名】 特許願  
【整理番号】 99-00929  
【提出日】 平成11年 9月21日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H04N 5/335  
【発明者】  
【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン  
内  
【氏名】 芝崎 清茂  
【特許出願人】  
【識別番号】 000004112  
【氏名又は名称】 株式会社ニコン  
【代理人】  
【識別番号】 100084412  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 永井 冬紀  
【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 004732  
【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1  
【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 撮像装置および電子カメラ

【特許請求の範囲】

【請求項1】

二次元状に配置される複数の光電変換素子と、  
前記各光電変換素子から電荷を転送する電荷転送回路と、  
前記電荷転送回路の電荷転送方向終端に接続され、電荷を電圧に変換して増幅  
する増幅器とを同一の半導体基板上に設置した撮像装置において、  
外部から与えられる制御信号にしたがって前記増幅器の電源を制御する増幅器  
電源制御回路を備えることを特徴とする撮像装置。

【請求項2】

請求項1に記載の撮像装置において、  
前記増幅器電源制御回路は、前記制御信号により前記増幅器のバイアス電流を  
変化させることを特徴とする撮像装置。

【請求項3】

請求項1または請求項2に記載の撮像装置において、  
前記電荷転送回路は、CCD (Charge Coupled Device) を用いて前記増幅器  
へ電荷を転送する回路であることを特徴とする撮像装置。

【請求項4】

請求項1または請求項2に記載の撮像装置において、  
前記電荷転送回路は、XYアドレス走査により電荷を前記増幅器へ読み出す回  
路であることを特徴とする撮像装置。

【請求項5】

請求項1～4のいずれかの項に記載の撮像装置を備えることを特徴とする電子  
カメラ。

【請求項6】

請求項5に記載の電子カメラにおいて、  
不要電荷の排出時と前記光電変換素子からの電荷読み出し時に前記制御信号に  
より前記増幅器に通常のバイアス電流を供給させ、それ以外の時に前記制御信号

により前記増幅器のバイアス電流を低減させることを特徴とする電子カメラ。

【請求項7】

請求項6に記載の電子カメラにおいて、  
露光時間が所定時間以下の露光時に前記制御信号により前記増幅器に通常のバ  
イアス電流を供給させることを特徴とする電子カメラ。

【請求項8】

二次元状に配置される複数の光電変換素子と、  
局所的な発熱源となる発熱部品と同一の半導体基板上に設置する撮像装置で  
あって、  
外部から与えられる制御信号にしたがって前記発熱部品の電源を制御する発熱  
部品電源制御回路を備えることを特徴とする撮像装置。

【請求項9】

請求項8に記載の撮像装置において、  
前記発熱部品はA/D変換器であることを特徴とする撮像装置。

【請求項10】

請求項8に記載の撮像装置において、  
前記発熱部品は信号処理プロセッサーであることを特徴とする撮像装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、固体撮像素子を用いた撮像装置とその撮像装置を備えた電子カメラ  
に関する。

【0002】

【従来の技術】

二次元状に配列されたフォトダイオードなどの光電変換素子によって光強度分  
布に応じた電荷に変換し、蓄積電荷を各光電変換素子からCCD (Charge Coupled  
Device)などの電荷転送素子を介してフローティング・ディフュージョンア  
ンプへ転送し、蓄積電荷を電圧に変換するとともに増幅して出力する撮像装置が  
知られている。

## 【0003】

図5は従来の撮像装置の構成を示す。

半導体基板（シリコン基板）20上には複数の光電変換素子1が二次元状に配列されている。これらの光電変換素子1には列ごとに電荷転送素子2が配置され、蓄積電荷を列方向に転送している。列方向の各電荷転送素子2の電荷転送方向終端には行方向の電荷転送素子3が接続され、列方向に転送された電荷をさらに行方向に転送している。この行方向の電荷転送素子3の電荷転送方向終端にはフローティング・ディフュージョンアンプ4が接続され、電荷を電圧に変換して増幅し、出力端子8から出力している。

## 【0004】

この明細書では、電荷転送素子の転送方向終端に接続され、転送された電荷を電圧に変換して増幅するフローティング・ディフュージョンアンプを単に”出力アンプ”と呼ぶことにする。

## 【0005】

出力アンプ4は正電源7に接続されるとともに、抵抗器5を介して負電源6に接続され、正電源7と負電源6との間に印加される電源電圧に応じたバイアス電流が流れる。抵抗器5はバイアス電流調整用抵抗である。なお、光電変換素子1および電荷転送素子2、3へも電源が供給されるが、それらの電源回路の図示を省略する。

## 【0006】

## 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述した従来の撮像装置では、光電変換素子1、電荷転送素子2、3および出力アンプ4が同一の半導体基板20上に設けられているので、図6に示すように発熱の大きな出力アンプ4の熱が時間経過とともに周囲の光電変換素子1へ伝わっていき、発熱源の出力アンプ4に近い光電変換素子1ほど加熱されて大きな暗電流が発生し、図7に示すように画像信号の黒レベルを押し上げて発熱源の近傍にいわゆる”暗電流ムラ”を発生するという問題がある。

## 【0007】

本発明の目的は、撮像装置の局所的な発熱に起因する暗電流ムラの発生を防止

することにある。

### 【0008】

#### 【課題を解決するための手段】

発明の一実施の形態の構成を示す図1および図2に対応づけて本発明を説明すると、

(1) 請求項1の発明は、二次元状に配置される複数の光電変換素子1と、各光電変換素子1から電荷を転送する電荷転送回路2, 3と、電荷転送回路2, 3の電荷転送方向終端に接続され、電荷を電圧に変換して増幅する増幅器4とを同一の半導体基板20上に設置した撮像装置に適用される。

そして、請求項1の発明は、外部から与えられる制御信号11にしたがって増幅器4の電源を制御する増幅器電源制御回路21を備えることにより、上記目的を達成する。

(2) 請求項2の撮像装置は、増幅器電源制御回路21によって、制御信号11により増幅器4のバイアス電流を変化させるようにしたものである。

(3) 請求項3の撮像装置は、電荷転送回路2, 3を、CCDを用いて増幅器4へ電荷を転送する回路としたものである。

(4) 請求項4の撮像装置は、電荷転送回路2, 3を、XYアドレス走査により電荷を増幅器4へ読み出す回路としたものである。

(5) 請求項5の発明は、請求項1～4のいずれかの項に記載の撮像装置を備えた電子カメラである。

(6) 請求項6の電子カメラは、不要電荷の排出時と光電変換素子1からの電荷読み出し時に制御信号11により増幅器4に通常のバイアス電流を供給させ、それ以外の時に制御信号11により増幅器4のバイアス電流を低減させるようにしたものである。

(7) 請求項7の電子カメラは、露光時間が所定時間以下の露光時に制御信号11により増幅器4に通常のバイアス電流を供給させるようにしたものである。

(8) 請求項8の発明は、二次元状に配置される複数の光電変換素子と、局所的な発熱源となる発熱部品とを同一の半導体基板上に設置する撮像装置であって、外部から与えられる制御信号にしたがって発熱部品の電源を制御する発熱部品

電源制御回路を備えることにより、上記目的を達成する。

(9) 請求項9の撮像装置の発熱部品はA/D変換器である。

(10) 請求項10の撮像装置の発熱部品は信号処理プロセッサーである。

#### 【0009】

上述した課題を解決するための手段の項では、説明を分かりやすくするために一実施の形態の図を用いたが、これにより本発明が一実施の形態に限定されるものではない。

#### 【0010】

##### 【発明の実施の形態】

図1および図2に一実施の形態の構成を示す。なお、図5に示す従来の撮像装置の構成機器と同様な機器に対しては同一の符号を付して説明する。

半導体基板（シリコン基板）20上にフォトトランジスターなどの複数の光電変換素子1を二次元状に配列し、列ごとにCCDなどの電荷転送素子2を配置して蓄積電荷を列方向に転送する。また、列方向の各電荷転送素子2の転送方向終端に行方向の電荷転送素子3を接続し、列方向の各電荷転送素子2により転送された電荷を行方向に転送する。さらに、行方向の電荷転送素子3の転送方向終端にフローティング・ディフュージョンアンプ、すなわち出力アンプ4を接続し、電荷を電圧に変換して増幅し、出力端子8から外部の画像処理回路などへ出力する。

#### 【0011】

上述した従来の撮像装置では、光電変換素子1および電荷転送素子2, 3と同一の半導体基板20上に設置される出力アンプ4が局所的な発熱源となり、“暗電流ムラ”の発生原因となっていた。

#### 【0012】

そこで、この実施の形態では、局所的な発熱源である出力アンプ4の電源を制御し、出力アンプ4を動作させる必要がないときに、出力アンプ4のバイアス電流を抑制して発熱を最小限に抑えるアンプ電源制御回路21を撮像装置に附加し、暗電流ムラの発生を防止する。

## 【0013】

図1はアンプ電源制御回路21を負電源6側に設けた例を示し、図2はアンプ電源制御回路21を正電源7側に設けた例を示す。

アンプ電源制御回路21は、制御信号11により開閉するスイッチ素子9と抵抗器10の並列回路から構成される。制御信号11は撮像装置の外部から供給される信号であり、スイッチ素子9を開閉して出力アンプ4のバイアス電流を変える。抵抗器10は出力アンプ4を動作させる必要がないときのバイアス電流を調整するための抵抗器であり、抵抗器5は出力アンプ4を動作させる必要があるときの通常のバイアス電流を調整するための抵抗器である。

## 【0014】

電荷転送素子2、3により電荷を出力アンプ4へ転送し、出力アンプ4で電荷電圧変換と增幅を行う”電荷転送時”には、制御信号11によりスイッチ素子9を開路し、抵抗器10を短絡して抵抗器5により設定された通常のバイアス電流Iを出力アンプ4に供給する。この電荷転送時は出力アンプ4を動作させる必要があるときであり、電荷転送素子2、3により光電変換素子1の撮像電荷を出力アンプ4へ転送し、出力アンプ4から外部へ出力する撮像電荷の転送の他に、次のような不要電荷の転送が含まれる。すなわち、長時間露光前と、長時間露光後の電荷読み出し前に行われる不要電荷の排出処理において、不要電荷の一部を電荷転送素子2、3により出力アンプ4へ転送し、出力アンプ4を介して外部へ排出する不要電荷の転送が含まれる。

## 【0015】

一方、出力アンプ4を動作させる必要がないとき、つまり撮像電荷または不要電荷を転送しない”非電荷転送時”には、制御信号11によりスイッチ素子9を開路し、抵抗器5と直列に抵抗器10を挿入して出力アンプ4のバイアス電流をその抑制値I'まで低減する。

## 【0016】

なお、図1および図2において、光電変換素子1および電荷転送素子2、3へも電源が供給されるが、それらの電源回路の図示を省略する。また、負電源6をグランドラインまたは0Vラインとしてもよい。

## 【0017】

ここで、非電荷転送時のバイアス電流 $I'$ を調整するための抵抗器10の抵抗値R10の決定方法を説明する。

例えば、出力アンプ4の非電荷転送時のバイアス電流 $I'$ を電荷転送時の通常のバイアス電流 $I$ の $1/10$ にする場合には、抵抗器10の抵抗値R10を次のように設定すればよい。

## 【数1】

$$I = E / (R5 + ZA),$$

$$I' = E / (R5 + R10 + ZA),$$

$$I' / I = 1 / 10,$$

$$\therefore R10 = 9 * (R5 + ZA)$$

ここで、ZAは出力アンプ4の電源回路のインピーダンス、R5は抵抗器5の抵抗値、Eは正電源7と負電源6との間に印加される電源電圧である。

## 【0018】

なお、この実施の形態では非電荷転送時の出力アンプ4のバイアス電流 $I'$ を電荷転送時の通常のバイアス電流 $I$ の $1/10$ としたが、非電荷転送時のバイアス電流 $I'$ はこの実施の形態に限定されず、少なくとも露光時間の長いシャッター速度が設定された場合でも、出力アンプ4の発熱により暗電流ムラを発生しないバイアス電流であればよい。出力アンプ4の非電荷転送時のバイアス電流 $I'$ を0とすることもでき、その場合は抵抗器10の抵抗値R10を無限大、つまり抵抗器10を削除すればよい。

## 【0019】

また、アンプ電源制御回路21を半導体基板20上に設置してもよい。この場合は、半導体基板20上のアンプ電源制御回路21に正電源7、負電源6および制御信号11を供給する。

## 【0020】

図3は、一実施の形態の撮像装置を備えた電子カメラの、露光時間が所定時間より長い（シャッター速度が所定値より遅い）ときの撮像動作を示すタイムチャートである。

時刻  $t_1$ において、電子カメラのメインスイッチ（不図示）がオンされると、カメラが作動を開始する。時刻  $t_2$ で、レリーズボタン（不図示）の半押し時にオンする半押しスイッチ（不図示）がオンし、測光回路（不図示）により測光が行われ、測光結果に基づいてシャッター速度、すなわち露光時間が設定される。また、同時にAF回路（不図示）により撮影レンズ（不図示）の焦点調節状態が検出され、焦点検出結果に基づいて撮影レンズの焦点調節が行われる。

#### 【0021】

時刻  $t_3$ において、レリーズボタンが押し込まれてレリーズスイッチ（不図示）がオンすると、撮像装置の出力アンプ4に正電源7と負電源6を供給するとともに、光電変換素子1および電荷転送素子2、3に電源（不図示）を供給する。このとき同時に制御信号11によりスイッチ素子9を閉路し、出力アンプ4に電荷転送時の通常のバイアス電流Iを供給する。

#### 【0022】

シャッターがレリーズされてから実際にシャッターが開き始めるまでの時刻  $t_4 \sim t_5$ において電荷転送素子2、3の転送動作を行い、光電変換素子1および電荷転送素子2、3上にある不要電荷を、電荷転送素子3と平行に配設されるオーバーフロードレイン（不図示）へ排出する。このとき、不要電荷を完全にオーバーフロードレインへ排出することができないため、制御信号11によりスイッチ素子9を閉路し、出力アンプ4に通常のバイアス電流Iを供給して動作させ、オーバーフロードレインへ排出できない一部の不要電荷を出力アンプ4を介して出力端子8から撮像装置の外部へ排出する。

#### 【0023】

不要電荷の排出後の時刻  $t_7$ において、制御信号11によりスイッチ素子9を開路し、出力アンプ4のバイアス電流をその抑制値  $I'$ まで低減して露光時の出力アンプ4の発熱を避ける。なお、不要電荷の排出処理が終了する時刻  $t_5$ において直ちに出力アンプ4のバイアス電流を低減するようにしてもよい。

#### 【0024】

一方、時刻  $t_5$ で不要電荷の排出が完了してから一定時間後の時刻  $t_6$ において、シャッターを開き始める。シャッターは時刻  $t_8$ において完全に開放状態と

なるが、その後しばらくして露光が開始されるので、出力アンプ4のバイアス電流を低減する時刻は少なくともシャッターが完全に開放される時刻t<sub>8</sub>より早い時刻とする。露光中は光電変換素子1で光強度に応じた電荷蓄積を行う。

#### 【0025】

露光が終了したら時刻t<sub>9</sub>でシャッターを閉じるが、時刻t<sub>10</sub>でシャッターが完全に閉じられてから直ちに蓄積電荷の読み出しを開始するのではなく、長時間の露光後はもう一度電荷転送素子2, 3に蓄積された不要電荷の排出を行う。これは、露光時間が長いほど露光中に電荷転送素子2, 3に蓄積される不要電荷の量が多くなり、無視できないほどの量になるため、蓄積電荷の読み出し処理に先立って不要電荷の排出処理を行う。露光中に蓄積された不要電荷は、露光前の排出処理と同様に、不要電荷をオーバーフロードレインへ排出するとともに、排出できない一部の不要電荷を出力アンプ4を介して出力端子8から撮像装置の外部へ排出する。すなわち、時刻t<sub>10</sub>で制御信号11によりスイッチ素子9を開路し、出力アンプ4に通常のバイアス電流Iを供給して動作させ、時刻t<sub>11</sub>で電荷転送素子2, 3を転送動作させて排出処理を開始する。

#### 【0026】

時刻t<sub>12</sub>で不要電荷の排出処理が終了すると、時刻t<sub>13</sub>から電荷転送素子2, 3による蓄積電荷すなわち撮像電荷の転送動作を開始する。なお、露光中の不要電荷を排出した後にすぐに蓄積電荷の読み出し処理を開始するので、制御信号11によりスイッチ素子9を開路したままにし、出力アンプ4に電荷転送時の通常のバイアス電流Iを流し続ける。蓄積電荷の読み出し処理では、露光中に光電変換素子1に蓄積された電荷を電荷転送素子2, 3を介して出力アンプ4へ導き、出力アンプ4で転送電荷を順次電圧に変換して増幅し、出力端子8から外部の画像処理回路（不図示）へ出力する。

#### 【0027】

時刻t<sub>14</sub>で蓄積電荷の読み出し処理が終了すると、出力アンプ4の正電源7と負電源6、光電変換素子1、電荷転送素子2, 3などの撮像装置への電源の供給を停止するとともに、制御信号11によりスイッチ素子9を開路する。

## 【0028】

このように、二次元状に配置される複数の光電変換素子1と、各光電変換素子1から電荷を転送する電荷転送素子2, 3と、電荷転送素子2, 3の電荷転送方向終端に接続され、電荷を電圧に変換して増幅する出力アンプ4とを同一の半導体基板20上に設置した撮像装置において、外部から与えられる制御信号11にしたがって出力アンプ4の電源を制御するアンプ電源制御回路21を備え、アンプ電源制御回路21によって、制御信号21に応じて出力アンプ4のバイアス電流を変えるようにした。これにより、必要なときだけ出力アンプ4に電源、すなわち通常のバイアス電流Iを供給することができる。具体的には、不要電荷の排出時および撮像電荷の読み出し時、つまり電荷転送素子2, 3により出力アンプ4へ電荷を転送し、出力アンプ4で電荷電圧変換と増幅を行う必要がある時のみ、出力アンプ4へ通常のバイアス電流Iを供給し、それ以外の時は通常のバイアス電流Iよりも低い抑制値I'にバイアス電流を低減する。したがって、出力アンプ4からの局所的な発熱を最少限に抑制することができ、出力アンプ4周辺の光電変換素子1を加熱して暗電流が増加するのを防止でき、撮像画像における暗電流ムラの発生を防止することができる。その上、出力アンプ4を動作させる必要がないときは出力アンプ4のバイアス電流を低減することができるので、電子カメラのバッテリー消費を抑制することができる。

## 【0029】

図4は、一実施の形態の撮像装置を備えた電子カメラの、露光時間が所定時間以下で短い（シャッター速度が所定値以下で速い）ときの撮像動作を示すタイムチャートである。

露光時間が所定値以下で短いときは、不要電荷の蓄積量が少ないのでその排出処理が不要となり、シャッターレリーズから電荷読み出し終了までの一連の撮像時間が短い。したがって、一連の撮像期間中、出力アンプ4に通常のバイアス電流Iを流し続けても出力アンプ4の発熱量は少なく、出力アンプ4の周辺の光電変換素子1を加熱して暗電流を増加させることはない。

## 【0030】

メインスイッチのオンからシャッターレリーズまでの動作は、図3に示す露光

時間が長い場合の動作と同様である。時刻  $t_{22}$ において、レリーズボタンが押し込まれてレリーズスイッチ（不図示）がオンすると、撮像装置の出力アンプ4に正電源7と負電源6を供給するとともに、光電変換素子1および電荷転送素子2, 3に電源（不図示）を供給する。このとき同時に制御信号11によりスイッチ素子9を開路し、出力アンプ4に通常のバイアス電流Iを供給する。

#### 【0031】

その後、時刻  $t_{23} \sim t_{24}$ でシャッターを開放して露光、すなわち光電変換素子1により光強度に応じた電荷蓄積を行う。露光終了後にシャッターが閉じられると、時刻  $t_{24}$ で直ちに蓄積電荷の読み出し処理を開始する。電荷転送素子2, 3で電荷転送動作を行い、露光中に光電変換素子1に蓄積された電荷を電荷転送素子2, 3を介して出力アンプ4へ導き、出力アンプ4で転送電荷を順次電圧に変換して增幅し、出力端子8から外部の画像処理回路（不図示）へ出力する。

#### 【0032】

時刻  $t_{25}$ で蓄積電荷の読み出し処理が終了すると、出力アンプ4の正電源7と負電源6、光電変換素子1、電荷転送素子2, 3などの撮像装置への電源の供給を停止するとともに、制御信号11によりスイッチ素子9を開路する。

#### 【0033】

このように、露光時間が所定時間以下の短時間露光時には、制御信号11により出力アンプ4に通常のバイアス電流Iを供給させるようにした。露光時間が短い場合は出力アンプ4に通常のバイアス電流Iを流しても、短時間であるから出力アンプ4の発熱量は少なく、出力アンプ4の周辺の光電変換素子1を加熱して暗電流ムラを発生させることはない。むしろ、露光中に出力アンプ4に通常のバイアス電流Iが供給されているので、出力アンプ4は露光中からすでに安定状態にあり、露光後に直ちに撮像電荷を安定に読み出すことができ、総合的に撮像時間を短縮することができる。

#### 【0034】

ここで、出力アンプ4のバイアス電流を低減するか否かを判断するための露光時間の上記所定時間は、光電変換素子1および電荷転送素子2, 3の数量と配置

、出力アンプ4の配置などにより、個々の撮像装置に対して最適な値を決定すればよい。

#### 【0035】

なお、上述した一実施の形態では、電荷転送素子を用いて光電変換素子の電荷を読み出す形式の撮像装置を例に上げて説明したが、例えばMOS型撮像装置のように、XYアドレス走査により光電変換素子の電荷を読み出す形式の撮像装置に対しても、同一基板上に設置した出力アンプにより読み出した電荷を電圧に変換し、増幅する形式の撮像装置であれば本発明を適用することができ、上述した一実施の形態と同様な効果が得られる。

#### 【0036】

また、上述した一実施の形態では、单一の出力アンプ4を用いた例を示したが、複数の光電変換素子を複数のグループに分け、各グループごとに電荷転送素子を用いて蓄積電荷の読み出しを行い、グループごとの電荷転送素子の転送方向終端にそれぞれ出力アンプを設置して、電荷電圧の変換と増幅を行う撮像装置に対しても本発明を適用することができ、上述した一実施の形態と同様な効果を得ることができる。

#### 【0037】

上述した一実施の形態では光電変換素子の暗電流を増加させる発熱源として出力アンプを例に上げて説明したが、発熱源は出力アンプに限定されない。例えば、CMOS型の撮像装置では、光電変換素子と同一の半導体基板上に、アンプ、A/D変換器、あるいは信号処理プロセッサーなどを搭載することがある。アンプは上述したように局所的な発熱源となるが、A/D変換器や信号処理プロセッサーも高速で駆動すればするほど発熱量が多くなり、アンプと同様な局所的な発熱源となる。したがって、光電変換素子と同一の半導体基板上にA/D変換器や信号処理プロセッサーなどの局所的な発熱源を搭載する形式の撮像装置に対しても本発明を適用することができる。その場合には、A/D変換器や信号処理プロセッサーの電源を制御し、動作させる必要がある時のみ電源を供給したり、動作不要時にバイアス電流を低減することによって、発熱を抑制することができ、上述した一実施の形態と同様な効果を得ることができる。

## 【0038】

上述した一実施の形態では本発明の撮像装置を装備した電子カメラを例に上げて説明したが、本発明の撮像装置は電子カメラ以外の装置にも装備することができる。

## 【0039】

## 【発明の効果】

(1) 以上説明したように本発明の撮像装置によれば、複数の光電変換素子と電荷転送回路と増幅器とを同一の半導体基板上に設置した撮像装置に、外部から与えられる制御信号にしたがって増幅器の電源を制御する増幅器電源制御回路を備え、増幅器電源制御回路によって増幅器のバイアス電流を変化させるようにしたので、撮像装置の外部から増幅器の電源すなわちバイアス電流を変えることができ、必要なときだけ増幅器に通常のバイアス電流を供給することができる。これにより、増幅器からの局所的な発熱を最少限に抑制することができ、増幅器周辺の光電変換素子を加熱して暗電流が増加するのを防止でき、撮像画像における暗電流ムラの発生を防止することができる。その上、増幅器を動作させる必要がないときは増幅器のバイアス電流を低減することができるので、増幅器の電力消費を抑制することができる。

(2) また、本発明の電子カメラによれば、不要電荷の排出時と光電変換素子からの電荷読み出し時に、撮像装置の外部から制御信号により増幅器に通常のバイアス電流を供給させ、それ以外の時に制御信号により増幅器のバイアス電流を低減せざるようにしたので、増幅器からの局所的な発熱を最少限に抑制することができ、増幅器周辺の光電変換素子を加熱して暗電流が増加するのを防止でき、撮像画像における暗電流ムラの発生を防止することができる。その上、増幅器を動作させる必要がないときは増幅器のバイアス電流を低減することができるので、電子カメラのバッテリー消費を抑制することができる。

(3) さらに、本発明の電子カメラによれば、露光時間が所定時間以下の露光時には、制御信号により増幅器に通常のバイアス電流を供給せざるようにした。露光時間が短い場合は増幅器に通常のバイアス電流を流しても、短時間であるから増幅器の発熱量は少なく、増幅器周辺の光電変換素子を加熱して暗電流ムラを

発生させることはない。むしろ、露光中に増幅器に通常のバイアス電流が供給されているので、増幅器は露光中からすでに安定状態にあり、露光後に直ちに撮像電荷を安定に読み出すことができ、総合的に撮像時間を短縮することができる。

(4) さらにまた、本発明の撮像装置によれば、複数の光電変換素子と局所的な発熱源となる発熱部品とを同一の半導体基板上に設置する撮像装置に対し、撮像装置の外部から制御信号により発熱部品の電源を制御する発熱部品電源制御回路を備えたので、発熱部品を動作させる必要がある時のみ電源を供給したり、動作不要時にバイアス電流を低減することができる。これにより、発熱部品からの局所的な発熱を最少限に抑制することができ、発熱部品周辺の光電変換素子を加熱して暗電流が増加するのを防止でき、撮像画像における暗電流ムラの発生を防止することができる。その上、発熱部品を動作させる必要がないときは発熱部品のバイアス電流を低減することができるので、発熱部品の電力消費を抑制することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 一実施の形態の構成を示す図である。

【図2】 一実施の形態の構成を示す図である。

【図3】 露光時間が長いときの撮像動作を示すタイムチャートである。

【図4】 露光時間が短いときの撮像動作を示すタイムチャートである。

【図5】 従来の撮像装置の構成を示す図である。

【図6】 従来の撮像装置の問題点を説明するための図である。

【図7】 従来の撮像装置による暗電流ムラを示す図である。

#### 【符号の説明】

- 1 光電変換素子
- 2, 3 電荷転送素子
- 4 出力アンプ
- 5 抵抗器
- 6 負電源
- 7 正電源
- 8 出力端子

9 スイッチ素子

10 抵抗器

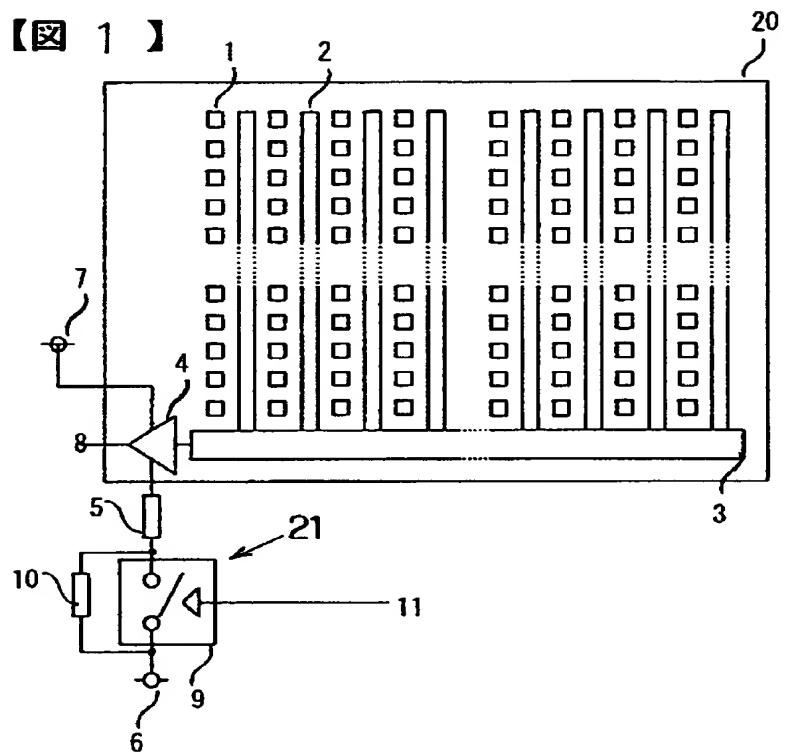
11 制御信号

20 半導体基板

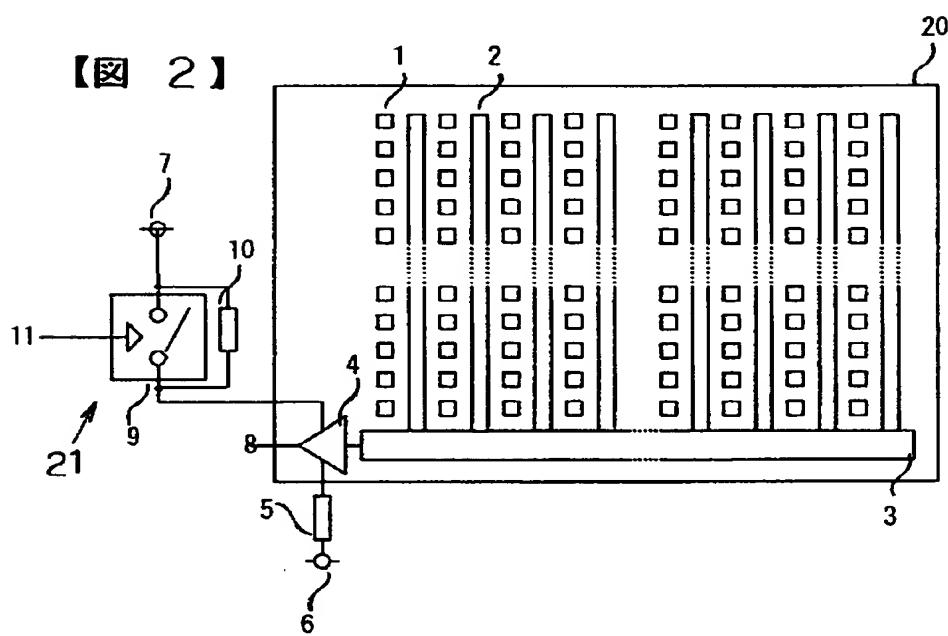
21 アンプ電源制御回路

【書類名】 図面

【図1】

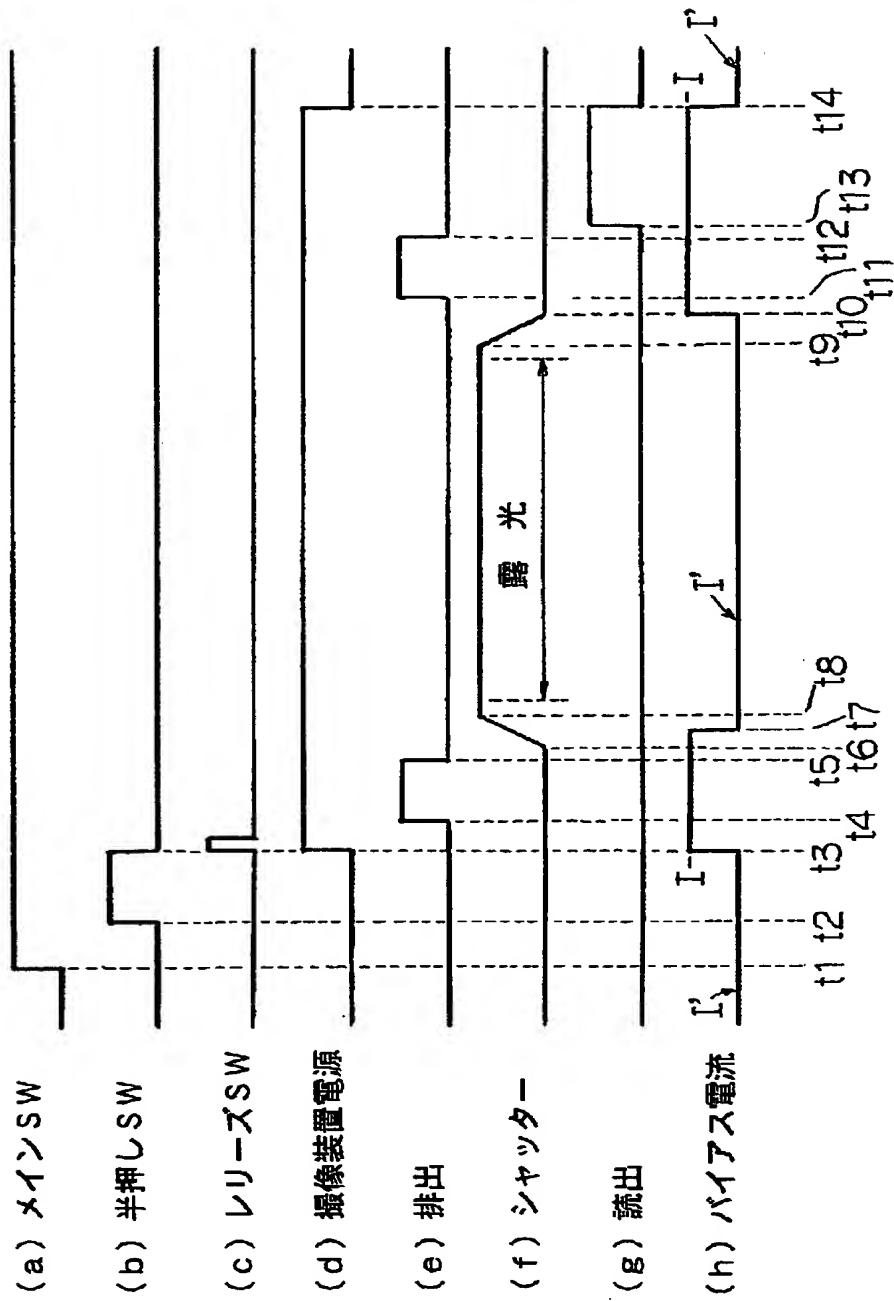


【図2】



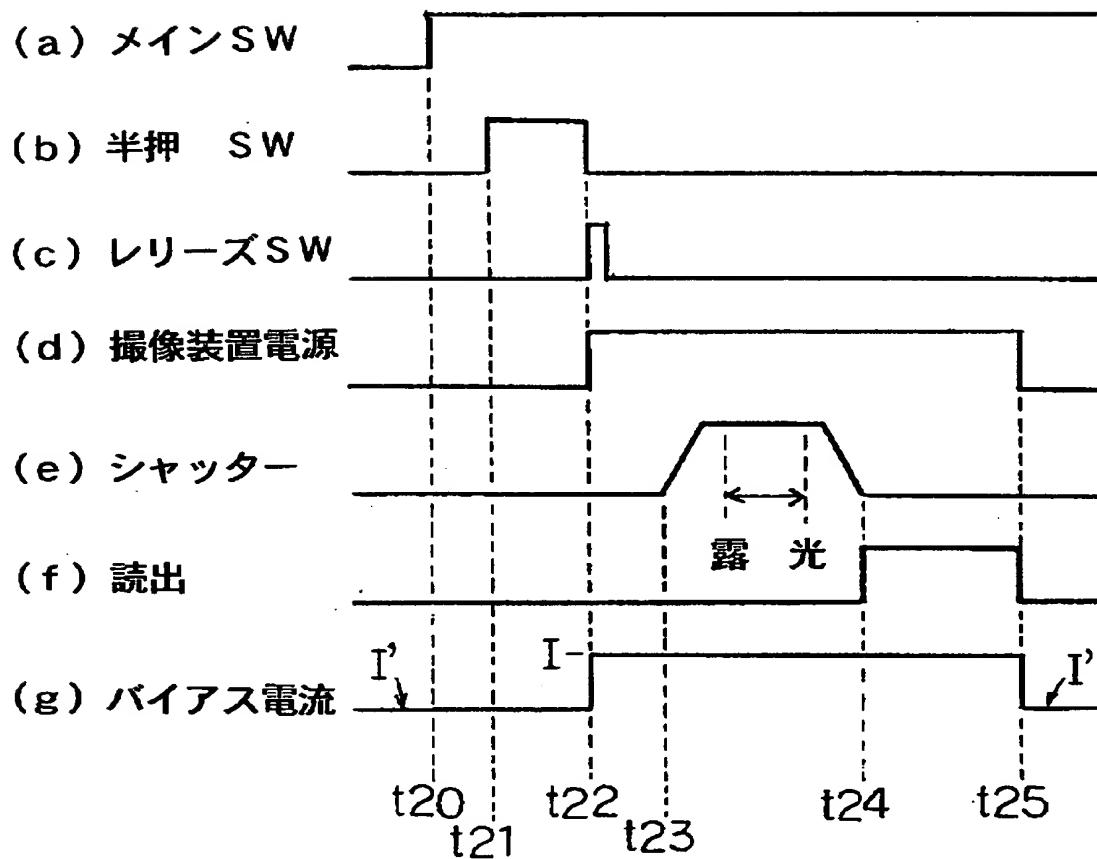
【図3】

【図3】

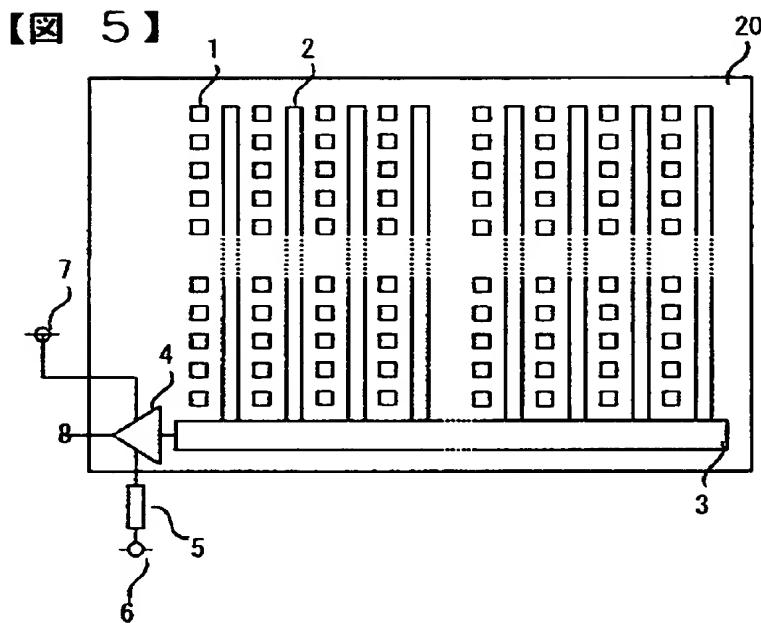


【図4】

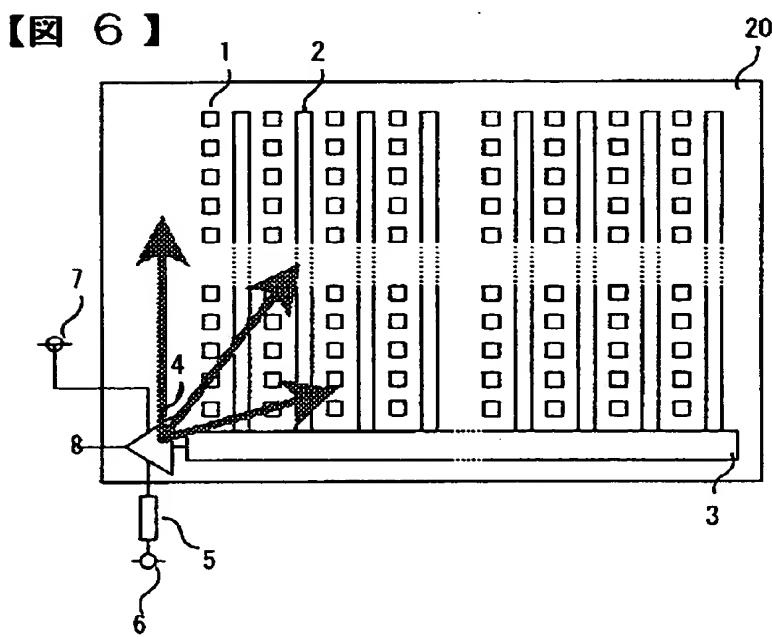
【図 4】



【図5】



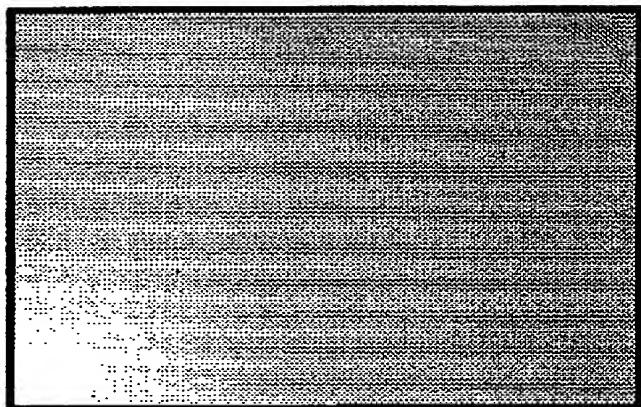
【図6】



特平11-267166

【図7】

【図7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 撮像装置の局所的な発熱に起因する暗電流ムラの発生を防止する。

【解決手段】 複数の光電変換素子1と電荷転送回路2, 3と増幅器4とを同一の半導体基板20上に設置した撮像装置に、外部から与えられる制御信号11にしたがって増幅器4の電源を制御する増幅器電源制御回路21を備え、増幅器電源制御回路21によって増幅器4のバイアス電流を変化させる。これにより、撮像装置の外部から増幅器4の電源すなわちバイアス電流を変えることができ、必要なときだけ増幅器4に通常のバイアス電流を供給することができる。したがって、増幅器4からの局所的な発熱を最少限に抑制することができ、増幅器周辺の光電変換素子1を加熱して暗電流が増加するのを防止でき、撮像画像における暗電流ムラの発生を防止することができる。その上、増幅器4を動作させる必要がないときは増幅器4のバイアス電流を低減することができるので、増幅器4の電力消費を抑制することができる。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号 [00004112]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

氏 名 株式会社ニコン